

(BO とその陽イオンラジカル塩の振動スペクトル KBr 法) 文献 59 より転載

C=C 二重結合吸収帯(矢印)
 BO^{2+} : 1456 cm^{-1}
 BO^+ : 1527 cm^{-1}
 $\text{BO}^{0.45+}$: 1596 cm^{-1}
 BO^0 : 1646 cm^{-1}

(BEDO-TTF の電荷移動度と分子内結合長) 文献 59 より転載

Mean dimensions of
BEDO-TTF (Å).

	BO	$\text{BO}_{2.4}\text{I}_3$	$(\text{BO})(\text{I}_3)$	$(\text{BO})(\text{I}_3)_2$
Oxidation State	0	+0.42	+1	+2
a	1.357	1.347	1.398	1.427
b	1.762	1.741	1.723	1.702
c	1.754	1.733	1.727	1.702
d	1.333	1.312	1.350	1.420
e	1.368	1.365	1.352	1.309

最近、Raman 分光法によって、BO 上の電荷移動度が相当な正確さを持って決定できることが分かってきた。¹²⁹ この場合、 ν_2 , ν_3 と呼ばれる BO の五員環外側 C=C、及び、中央 C=C 結合が、それぞれ主に関与した骨格振動の波数を用いて、電荷移動度(ρ)を算出する。

$$\rho = (1660.8 - \nu_2(\text{cm}^{-1})) / 74.1 \quad (\text{算出された}\rho\text{の精度は}\pm 0.1)$$

$$\rho = (1524.9 - \nu_3(\text{cm}^{-1})) / 109.0 \quad (\text{算出された}\rho\text{の精度は}\pm 0.05)$$

一般に、 ν_3 の方が散乱強度が大きく、かつ、算出した電荷移動度の精度も良い。しかし、特に有機アクセプター分子との錯体においては、常に両方の散乱ピークを見ることによって、散乱ピークの帰属を確認しつつ、電荷移動度の見積を行うべきであると言われている。

§ BO 錯体の蒸着膜への応用

文献 54, 57 の抄録

(BO)_{2.4}(I₃)錯体を 10⁻⁸ mbar の真空下、source 温度 130-150°C、基板温度 200-300 K で蒸着した。石英硝子基板の場合、錯体は少なくとも三方向に配向し、 $\sigma_{rt} < 10^{-1} \text{ Scm}^{-1}$ (Ea = 50 meV)であった。シリコンウェファー、(100)面への蒸着では錯体が一方向に配向していた。NaCl 基板への蒸着では錯体が一方向に配向し、BO 分子長軸が基板面に平行な配置を取っていた。この時、 $\sigma_{rt} < 1 \text{ Scm}^{-1}$ (Ea = 20 meV)であった。

更に、NaCl 基板を用いた蒸着時、途中で基板温度を変化させる事により(最初数 100 Å までは 200 K、その後、室温に上げて数 100 Å を蒸着する)、基板から有機膜を剥がし取れる程平坦で強靱な薄膜を作成できた。

§ BO 錯体の RDP 膜への応用

文献 66 の抄録

1-3 wt%の BO を含む高分子薄膜を、I₂または Br₂ を含む溶媒蒸気に曝すことによって表面に伝導性を持つポリマーフィルムを作成した。poly(carbonate)膜に I₂ ドープした場合、室温比抵抗 $1 \times 10^3 \Omega/\delta$ で 30 K まで金属的伝導度変化を示した。poly(diallylphthalate)膜に Br₂ ドープした場合、室温比抵抗 $1 \times 10^4 \Omega/\delta$ で 100 K まで金属的伝導度変化を示す透明な膜を得た。

文献 72 の抄録

BO-I 系 RDP 膜(grey-violet 色、液体ヘリウム温度まで金属的伝導挙動 system 1)を電解すると slightly grey で 30 K まで金属的挙動(それ以下では半導体的)を示す薄膜(system 2)となる。これらについて、PISHG(Photo Induced Second-Harmonic Generation)の実験を行った。PISHG に対して、system 1 で見られる、薄膜中のはっきりした微細結晶は不活性であるが、伝導性への寄与が小さい aggregated phase(結晶として観察できない部分)が活性であった。薄膜の発色は、後者が原因となっている。また、62 K 付近(伝導度には異常なし)に PISHG 信号にピークが現れた。これは、aggregated phase での構造層転移を示唆している。

文献 78 の抄録

1 wt%の BO を含む poly(bisphenol-A carbonate)膜を I₂または Br₂ を含む CH₂Cl₂ 蒸気に曝し、導電性薄膜を作成した。

臭素ドープ膜は、可視領域の吸収が非常に小さかった。 $\rho_{rt} = 10^4 \Omega/\delta$, ca. 100 K 迄金属的伝導度変化を示した。ヨウ素ドープ膜は、CV 法で電解還元するとほぼ無色になり、酸化すると可逆的に着色した。着色状態で、 $\rho_{rt} = 10^3 \Omega/\delta$ [ca. 10 K 迄金属的]、脱色状態で、 $\rho_{rt} = 2 \times 10^4 \Omega/\delta$, 30 K 迄金属的挙動を示した。

文献 87 の抄録(RDP 膜に関する部分)

これら表面導電性膜の近赤外~紫外吸収スペクトルを測定した。臭素ドープ膜の可視領域吸収帯について、明らかな入射角依存性があった。この吸収帯の帰属(分子長軸方向に分極した 2nd HOMO → HOMO の BO¹⁺分子内遷移)から、導伝層中で BO 分子がその長軸をフィルム面に対して垂直に配向していると推定された。

以上の速報的論文をまとめた形で、最近、文献 128 が出版されている。

§ 塩素塩の組成について

最初の報告は、ICSM'92 の proceedings に提出された²⁸。この時、30 mK の低温まで金属的挙動を示すにも拘わらず、組成として BO が+1 価に帯電した形となる (BO)Cl(H₂O)が報告された(さらに本原著論文中で結晶構造を示した Fig.6 では、軸の報告が誤って記述されている。原子座標とつきあわせると、図中の a, c-軸は、各々、b, a-軸のはずである)。

この組成と物性の矛盾は、錯体作成の追試と、SdH, dHvA 振動の測定^{46, 62}、及び、AMRO 測定⁶⁸により、組成を取り違えていたものと解釈された。即ち、(BO)₂Cl·3(H₂O)が正しい組成であり、BO は+0.5 価に帯電しているとされた。

その後、低温(160 K)での構造解析がなされ、陰イオン層中での酸素と塩素の占有率の精密化が行われた⁹¹。SdH のデータより BO 上の電荷移動度が+0.5 であることを認

め、最終的にはヒドロニウムイオンを含んだ、 $(\text{BO})_2\text{Cl}_{1.28}\cdot 0.28(\text{H}_3\text{O})\cdot 2.44(\text{H}_2\text{O})$ が正しい組成であると主張されている。

なお、塩素塩については複数の研究グループが独立に構造解析を行った結果、同じ結晶構造に対して、複数の格子定数が報告されている。Schweitzerらによる最初の報告²⁸では、ab-面が伝導面であり、b-軸がBOの擬似的なスタック軸(~ 5.1 Å)となっている。本頁では、これを'cell-1'と記す。これに対して、Dyachenko-Lyubovskiiらのグループ⁶⁹は、bc-面が伝導面になりb-軸がBOの擬似的なスタック軸(cell-2)、Shibaeva-Yagubskiiらのグループ⁹¹は、ab-面を伝導面に取りながら、a-軸がスタック軸となる方向に単位格子(cell-3)を規定している。

§ ReO_4 塩の相転移現象について

一般にBOの導電性錯体は、絶縁化等の明瞭な相転移現象を示さず、伝導度の温度変化を追跡しても最低温度付近で緩やかに半導体的挙動に移行する場合が多い。超伝導転移の発現も希で、現在までに、 $(\text{BO})_3\text{Cu}_2(\text{NCS})_3$ と $(\text{BO})_2\text{ReO}_4(\text{H}_2\text{O})$ のみが、各々、約 1 K、及び、約 2.5-3.5 Kの臨界温度(onset)を持つと報告されている。この内、 ReO_4 塩は、発見当初から、室温から超伝導状態に至るまでの冷却において、複数の相転移が観測されると報告されていた。これらの機構を理解する為に、特に磁場下での輸送現象の検討が成されてきた。本節では、その幾つかを列挙する。

なお、 ReO_4 塩についても塩素塩同様、同一の結晶構造に対して、異なった単位格子が規定され、混乱を起こしかねない状況にある。Schweitzerらによる最初の報告では、ac-面が伝導面でありBO分子はc-軸方向にスタックしている(本頁では'cell-1'と呼ぶ)。これに対して、Yagubskii-Shibaevaらのグループは、ab-面が伝導面、BOスタッキング方向がa-軸方向となる格子を使っている(cell-2)。(調査者注: これら二種類の格子の関係は、文献 56 の脚注に記されているが、その記述は再確認を要する)。

1991年、Schweitzer(独)らによる最初の報告¹⁸では、213 Kに低温側で伝導度が増大する金属-金属転移(MM-転移)、80-90 Kで熱電能に折れ曲がりを与えるMM転移、更に35 K付近で緩やかに半導体化した後、超伝導状態に入ると報告されている。

翌年、この追試とも言うべきロシアからの報告²⁰でも、直流伝導度の温度変化から、220-205 Kにhysteresisを持つMM転移と、35 K付近での半導体化が確認された。10¹⁰ Hzのマイクロ波を用いた伝導度測定では35 Kの半導体化が見られなかった事から、この転移はSDW、或いは可能性は低いがCDWによるものであろうと推定された。同時に加圧実験も行われ、加圧するに従って、220-205 KのMM転移が低温側に移り伝導度の飛びが小さくなる、35 K転移は抑制され抵抗の立ち上がりが小さくなると同時に超伝導転移も消失することが観測されている。これら加圧に伴う変化は、Schweitzerら自身も同時期に報告しており、表中に記した通り、MM転移点の圧依存性を経験式として与えている²¹。

1994年に入り、独、口両グループは磁場下での挙動を報告し始めた。SchweitzerらのグループはHall係数、ESR、磁気抵抗の測定を同時に報告している³⁷。213 KのMM転移点で、スピン磁化率が急減し、かつ、Hall抵抗が変化しない事から、この転移点では伝導担体の緩和時間が伸びていると推定した。0.5-4.2 K、6-24 Tの条件下、pocket sizeがBZの0.7、及び、1.5%に対応するSdH振動を観測した。バンド計算の結果、1.7%の面積を持つelectron、3.4%の面積を持つholeのポケットが得られた事から、実測のpocketをそれぞれこの順に帰属した。また、100 K以下でスピン磁化率が徐々に減少して行く事を見出し、バンド計算で得られるelectron、holeのポケットを連結する発想で、35 K転移の源として、hidden nestingによるSDW生成を推測した。同時期、ロシアでもSdHが観測され、同様のポケットサイズが見積もられた⁴¹。

1996年Laukhin-Jeromeらは、11 kbarの加圧下での磁気抵抗測定を行った^{56,67}。ここで、0.4-3.6 Kの零磁場を含む磁気抵抗のデータから、TMTSF系との類似点を見出し、35 K転移がFISDWであり、冷却、加圧によりnestingが促進されると推定した。nestingが不完全な状態で起こるFISDWと超伝導が競合する事により、超伝導転移温度の圧依存性が小さくなった($dT_c/dP = 0.2 \text{ K/kbar}$)との解釈も提出した。しかしcyclotron massが小さすぎる事等、問題点が残った。

Laukhinらは、更に、1997年52 Tまで磁場を上げて、1.7-4.2 Kでの磁気抵抗測定を行った⁷⁶。低磁場側では、従来通り、0.7、及び、1.5-1.6%のcross sectionに対応するSdHの重ね合

わせが見られた。10-14 T を境に、それ以上の磁場では、大きい方のポケットに対応する振動の強度が下がり、新たに、その 2 倍の周期を持つ振動が出現した。この原因として magnetic break down も考えられると記している。

1998 年に至り、Shibaeva-Yagubskii らは、まず 220-205 K での MM 転移を理解する為に、170 K での X-線構造解析を行った⁹⁰。その結果、転移後(170 K)では、陰イオン層中の水分子回りの環境が室温よりも対称的になっている事を見出した。ドナー層中では、ほとんど変化が起きていないことを考慮し、伝導層外での Coulomb ポテンシャルの変化が伝導度を向上させたのではないかと推測している。更に、この MM 転移後も、Fermi 面がほとんど変化していないことから、35 K の半導体化も、Fermi 面の nesting によるとは考えにくい(SDW は生じにくい)と推論している。更に、同グループは、試料を真空下に置いたところ超格子が観測され、この試料を大気中に放置することにより、超格子が消失することを見出した。この説明として、結晶からの水分子の脱離と、再吸収が起きていると考えている。¹²⁰

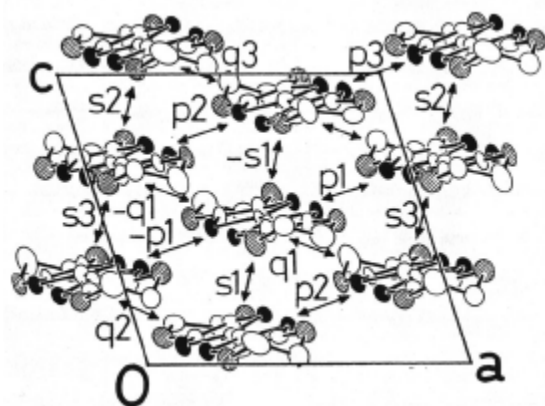
ICSM'98 では、Laukhin, Canadell, Singleton らが共同して、文献 76 で示された磁場誘起相転移に伴う Fermi 面変化を検出しようとした⁹⁶。15 T(1.8 K),及び、30 T(1.7 K, 4.2 K)の条件下 AMRO 測定を行った。cross section の大きさはいずれの磁場下でも、BZ の 8.5 %程度であり、15 T で既に高磁場状態に入っている事が判明した。また、Agosta らは、 H_{c2} の温度変化を測定し、 $T_c(1.6 K)$ の 1/4 程度の温度以下でこれが急激に大きくなる事を報告している。¹¹⁹ 同様の現象が見られる λ -(BETS)₂GaCl₄ とも比較しつつ、この T- H_{c2} 曲線の変化を、超伝導オーダーパラメータの変化(s-波から d-波状態等)によるのではないかと論じている。

調査者の印象では、 ReO_4 塩の示す相転移は、220-205 K での MM 転移で陰イオン層内での再配向が起きている事以外、直接的な転移機構の観測はなされていない。各原著論文の著者が口々に訴えている様に、今後更に実験事実を積み重ねなければ、その機構は理解できないと考えられる。

§ BEDO-TTF 錯体のバンド構造

BEDT-TTF 系同様、拡張 Hückel 法に基づく強結合近似バンド計算がなされている。文献 58 では、統一したパラメーターを用いて多数の計算が行われている。ここでは、原子軌道として、H1s, C2s, 2p, O2s, 2p, S3s, 3p, 3d 軌道がすべて single ζ で扱われている。以下に、その結果を転載する。また、計算途中に得られる分子間重なり積分については、最後にまとめた。また、本頁では、各 Fermi 面の図は小さく縮小され軸方向(k_x, k_y, k_z)が不鮮明になっているが、X, Y, Z の各点が、各々、 $(\pi/2\mathbf{a}, 0, 0)$, $(0, \pi/2\mathbf{b}, 0)$, $(0, 0, \pi/2\mathbf{c})$ に対応しているので判読していただきたい。

I₃-型塩



重なり積分は、大別して、BO のスタック方向(s), side-by-side 方向(p, q)の三種である。独立な分子数に応じて、更に各々の重なり積分が何種類かに細分される。

分散, DOS, Fermi 面の形状は、下記の通り。基本的には二次元の閉じた Fermi 面を持つが、それが単位格子中の BO 分子数に応じて順次折り返された形となっている。

